



فصل ۲

تحلیل مدارهای الکترونیکی



در حال حاضر الکترونیک کلید فتح شگفتی‌های جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوی پیوند خورده است. علاوه بر وسایل الکترونیکی از جمله دستگاه‌های مخابراتی مثل رادیو، تلویزیون، ضبط صوت و تصویر، انواع وسایل پزشکی، صنعتی، نظامی، در دیگر وسایل غیرالکترونیکی هم، کمتر وسیله‌ای را می‌توان یافت که الکترونیک در آن دخالتی نکرده باشد. از جمله در اتومبیل و صنایع حمل و نقل، وسایل خانگی نقش الکترونیک بسیار فعال و جالب توجه شده است. با توجه به این مختصر می‌توان نتیجه گرفت که امروزه الکترونیک برای همه افرادی که به نحوی با امور فنی درگیرند لازم است و به فراخور حرفه خویش باید از این رشته اطلاعی داشته باشند. یکی از مصداق‌های عملی در اهمیت الکترونیک دفاع از امنیت ملی کشور است به طور مثال می‌توان به هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین فوق پیشرفته آمریکایی به نام RQ-۱۷۰ اشاره کرد که به حریم کشور تجاوز کرده بود و توسط نیروهای جنگ الکترونیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت کنترل درآمد و به صورت سالم به زمین نشانده شد و چندی بعد با تکیه بر دانش الکترونیک و هوا فضا نمونه ایرانی آن مهندسی معکوس و ساخته شد.

واحد یادگیری: تحلیل مدارهای الکترونیکی

آیامی دانید



- پرکاربردترین قطعه الکترونیکی چیست؟
- چگونه باید ترانزیستور را تغذیه کنیم؟
- انواع ترانزیستورها و کاربرد آنها را می‌شناسید؟
- انواع تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری به چه منظور استفاده می‌شوند؟
- چگونه ترانزیستور عمل تقویت را انجام می‌دهد؟
- مشخصات و ویژگی‌های تقویت‌کننده‌های مختلف چیست؟
- مدار مجتمع (آی سی) چیست؟
- تقویت‌کننده عملیاتی (op_Amp) چیست و کاربرد آن چگونه است؟

هدف از این شایستگی عبارت است از:

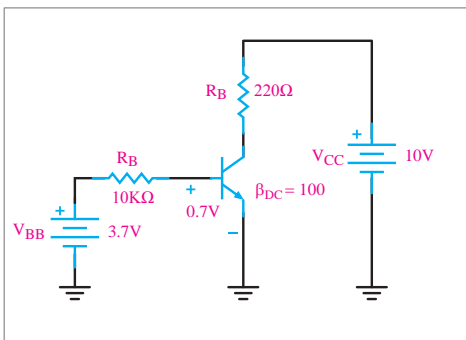
- ۱ بررسی نواحی کار ترانزیستورها
- ۲ ولتاژها و جریان‌های پایه‌های ترانزیستور را در مدار بایاس محاسبه کند.
- ۳ مقایسه سه نوع آرایش تقویت‌کننده ترانزیستوری
- ۴ بررسی تقویت‌کننده‌های خاص (تفاضلی، دارلینگتون و کامپلی منتاری)
- ۵ ساخت یک تقویت‌کننده صوتی عملی
- ۶ نماد و شکل ظاهری تقویت‌کننده عملیاتی
- ۷ بررسی و تحلیل مدارهای تقویت‌کننده عملیاتی و کاربرد آن
- ۸ ساختمان ترانزیستور اثر میدان (FET)، نماد و انواع آنها
- ۹ کاربرد ترانزیستور اثر میدان به‌عنوان سوئیچ

استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی، هنرجویان می‌توانند تحلیل، طراحی و ساخت مدارات بایاس ترانزیستوری، تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری و تقویت‌کننده‌های عملیاتی را انجام دهند.

بایاس ثابت

با توجه به شکل زیر مقادیر I_B و I_C و V_{CE} را محاسبه کنید.

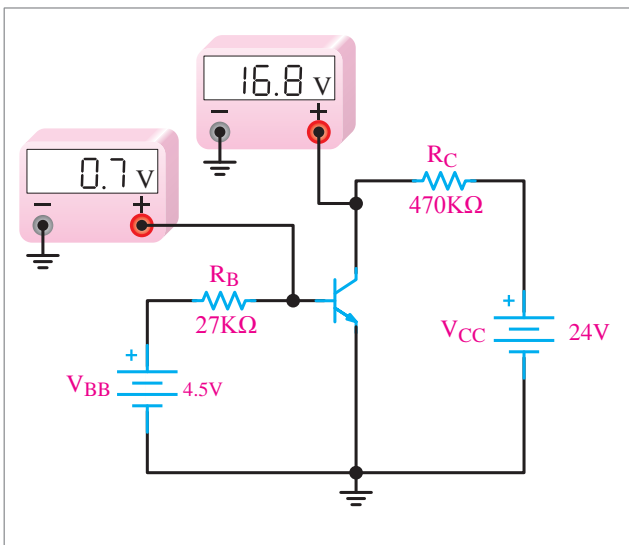


جواب:

$$V_{CE} = ۳/۴ \text{ ولت} \quad I_C = ۳۰ \text{ mA} \quad I_B = ۰/۳ \text{ mA}$$

۱

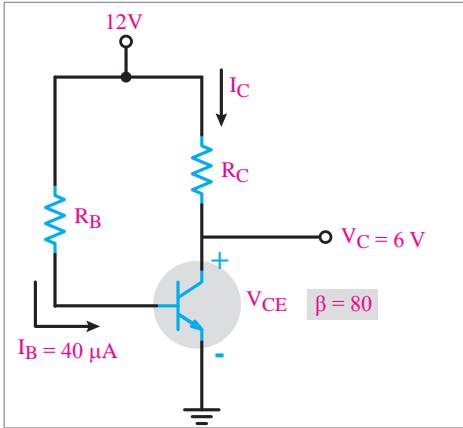
β را در شکل زیر محاسبه کنید.



جواب: $\beta = ۱۱۰$

۲

با استفاده از اطلاعات شکل، مقادیر زیر را تعیین کنید:
 V_{CE} (ت) R_B (پ) R_C (ب) I_C (الف)



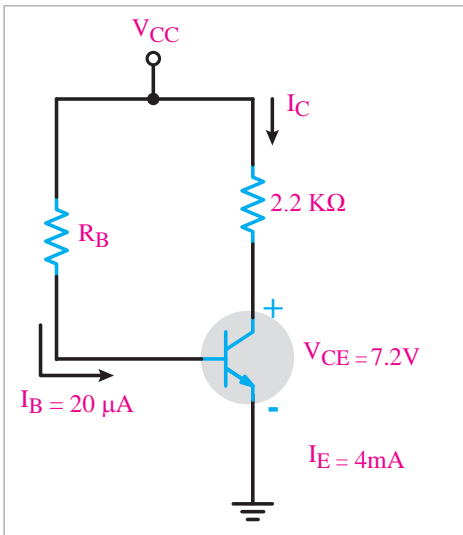
راهنمایی: ابتدا از رابطه $I_C = \beta I_B$ مقدار I_C را محاسبه و سپس KVL خروجی را بنویسید.

جواب:

$I_C = 3/2 \text{ mA}$ $R_C = 2/8 \text{ k}\Omega$
 $R_B = 28/5 \text{ k}\Omega$ $V_{CE} = 6 \text{ ولت}$

۳

با استفاده از اطلاعات شکل، مقادیر زیر را به دست آورید:



V_{CC} (ب) I_C (الف)
 R_B (ت) β (پ)

جواب:

$I_C = 4 \text{ mA}$ $V_{CC} = 16 \text{ v}$ $\beta = 20$
 $R_B = 76/5 \text{ k}\Omega$

۴

R_C و R_B را در یک آرایش تغذیه ثابت به دست آورید به شرطی که $V_{CC} = 12 \text{ v}$ ، $\beta = 80$ و $I_{CQ} = 2/5 \text{ mA}$ با $V_{CEQ} = 6 \text{ v}$ باشد. از مقادیر استاندارد استفاده کنید. ($V_{BE} = 0/6 \text{ v}$)

جواب:

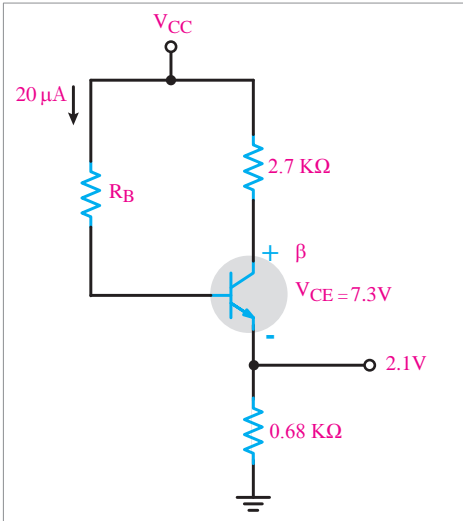
$R_C = 4/2 \text{ k}\Omega$ $R_B = 380 \text{ k}\Omega$

۵

بایاس ثابت با مقاومت امیتر

با اطلاعات ارائه شده در شکل، مقادیر زیر را به دست آورید:

الف) β ب) V_{CC} پ) R_B



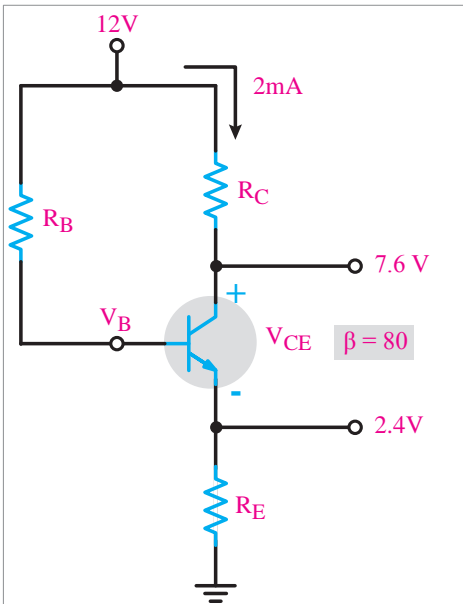
راهنمایی:
$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

جواب: $V_{CC} = 17/5$ $R_B = 74 \text{ k}\Omega$ $\beta = 15$

۱

با استفاده از اطلاعات ارائه شده در شکل، مقادیر زیر را به دست آورید: ($V_{BE} = 0.6$)

الف) R_C ب) R_E پ) R_B ت) V_{CE}



راهنمایی:
$$R_E = \frac{V_E}{I_E}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C}$$

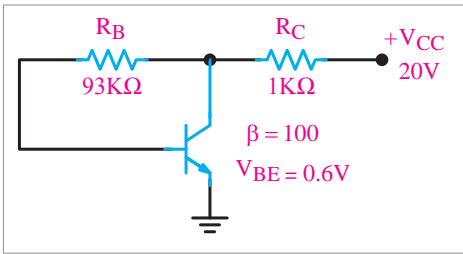
جواب: $R_C = 2/2 \text{ k}\Omega$ $R_E = 1/2 \text{ k}\Omega$ $R_B = 360 \text{ k}\Omega$ $V_{CE} = 5/2 \text{ V}$

۲

بایاس خودکار (بایاس فیدبک کلکتور)

مقادیر نقطه کار (V_{CE} , I_C , I_B) را برای مدار زیر محاسبه کنید.

جواب: $V_{CE} = 9/9 \text{ V}$ $I_C = 1.0 \text{ mA}$ $I_B = 0.1 \text{ mA}$



۱

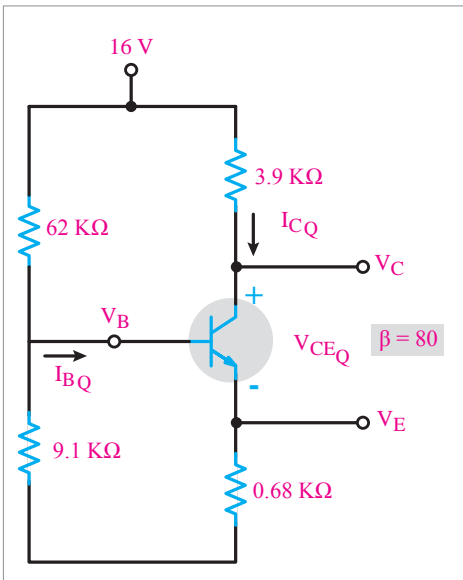
بایاس مقسم ولتاژ یا تغذیه سرخود

در مدار تغذیه مقسم ولتاژ شکل زیر را تعیین کنید: ($V_{BE} = 0.6 \text{ V}$)

الف) I_C ب) V_{CE} پ) V_C ت) V_E ث) V_B

جواب: $V_B = 2 \text{ V}$ $V_E = 1/4 \text{ V}$ $I_C = 2 \text{ mA}$

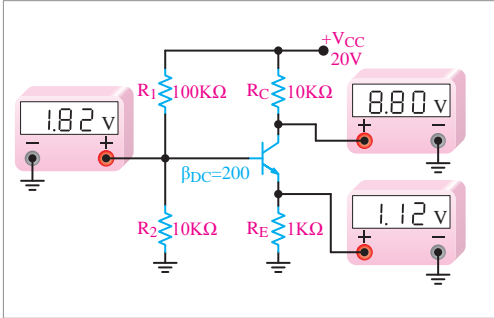
$V_C = 8/2 \text{ V}$ $V_{CE} = 6/8 \text{ V}$



۱

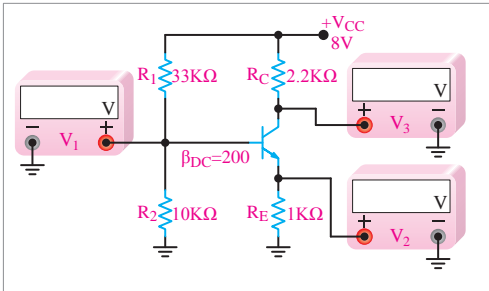
فصل ۲: تحلیل مدارهای الکترونیکی

با استفاده از روابط مربوط به بایاس سرخود اثبات کنید که مقادیر نشان داده شده توسط ولت‌مترهای شکل صحیح است. ($V_{BE} = 0.7V$)



۲

مقادیری که ولت‌مترهای V_1 و V_2 و V_3 در مدار زیر باید نشان بدهند را محاسبه کنید. ($V_{BE} = 0.7V$)



۳

جواب: $V_C = 5/36 \approx 5/4$ $V_E = 1/2V$ $V_B = 1/86 \approx 1/9$

منحنی مشخصه‌های ترانزیستور

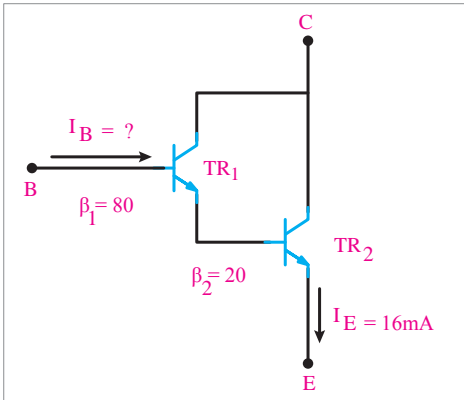
منحنی مشخصه خروجی را رسم کنید و نواحی کار ترانزیستور را روی آن مشخص کنید.

۱

تقویت کننده ترانزیستوری

| تقویت کننده ترانزیستوری | |
|--|---|
| <p>یک تقویت کننده تفاضلی در حالت تفاضلی، باید دارای بهره بسیار زیاد و در حالت سیگنال مشترک، بهره بسیار کم، در حدود صفر، داشته باشد. صحیح <input type="checkbox"/> غلط <input type="checkbox"/></p> <p>جواب: صحیح</p> | ۱ |

Darlington Pair زوج دارلینگتون



با توجه به مدار شکل مقابل مطلوب است:

الف) نام مدار

ب) بهره جریان (β_T)

ج) I_B

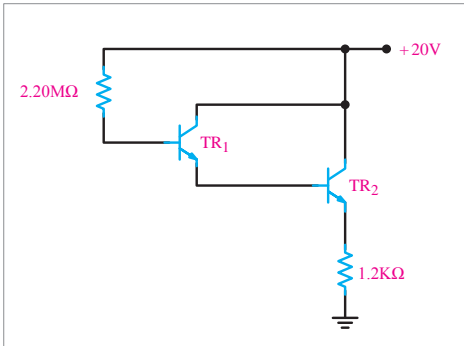
الف) زوج دارلینگتون

ب) $\beta_T = 1600$

$I_B = 10 \mu A$

۱

در مدار شکل زیر با فرض $\beta_1 = \beta_2 = 50$ و $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.6V$ چه قدرتی در ترانزیستور TR_2 تلف می شود؟



راهنمایی: قدرت تلف شده یعنی $P_C = V_{CE} \times I_C$

ورودی kV_L

$-V_{CC} + R_B I_B + V_{BE1} + V_{BE2} + R_E I_E = 0$

خروجی kV_L

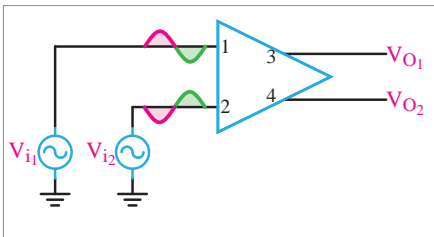
$-V_{CC} + V_{CE} + R_E I_E = 0$

جواب: $I_C = 9 \text{ mA}$ $V_{CE} = 9/2 \text{ V}$

$P_C = 82/8 \text{ mW}$

۲

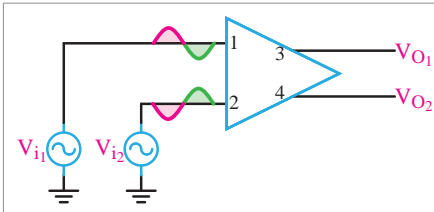
تقویت کننده تفاضلی



باتوجه به مدار مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید:
 الف) تقویت کننده تفاضلی در چه حالتی استفاده شده است؟
 ب) کاربرد مدار در کجاست؟
 جواب: الف) در حالت سیگنال مشترک
 ب) حذف نویز

۱

در تقویت کننده تفاضلی زیر شکل موج های V_{O1} و V_{O2} را رسم کنید.
 جواب:



۲

تقویت کننده تفاضلی نمی تواند سیگنال را از نویز تفکیک کند.
 صحیح غلط
 جواب: غلط

۳

یک تقویت کننده تفاضلی در حالت تفاضلی، باید دارای بهره بسیار زیاد و در حالت سیگنال مشترک، بهره بسیار کم، در حدود صفر داشته باشد. صحیح غلط
 جواب: صحیح

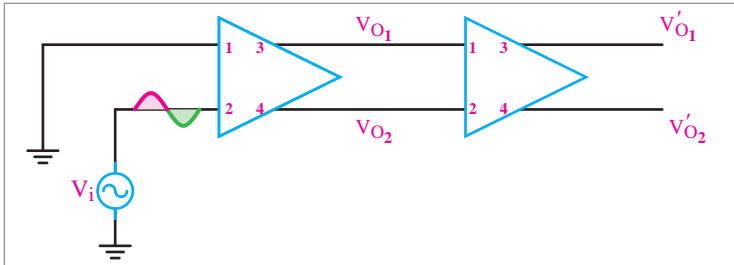
۴

در تقویت کننده تفاضلی اگر بهره حالت تفاضلی ۱۲۵۰۰ و بهره حالت سیگنال مشترک ۰/۲۵ باشد. $CMRR$ را محاسبه کنید. $CMRR$ بر حسب دسی بل را به دست آورید.
 جواب: $CMRR = 20 \cdot \text{Log} 50000 = 94$

۵

با توجه به شکل زیر، شکل موج‌های V_{O1} و V_{O2} و V'_{O1} و V'_{O2} را با توجه به شکل سیگنال ورودی V_i رسم کنید.

جواب:



۶

اگر به تقویت کننده تفاضلی شکل زیر سیگنال‌های هم دامنه و هم فاز اعمال شود:

الف) مقدار V_{O1} و V_{O2} را به دست آورید.

ب) با توجه به شکل، تقویت کننده تفاضلی در چه حالتی استفاده شده است؟

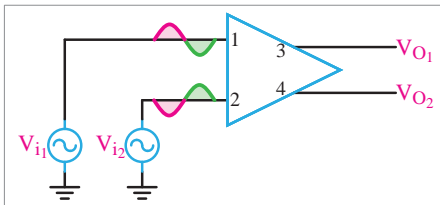
ج) از این حالت تقویت کننده تفاضلی به چه منظوری استفاده می‌شود؟

جواب:

الف) $V_{O1} = 0$ $V_{O2} = 0$

ب) حالت سیگنال مشترک

ج) حذف نویز



۷

تقویت کننده (پوش - پول)

با توجه به مدار مقابل، پاسخ دهید:

الف) نام مدار

ب) وظیفه ترانزیستور TR_3

ج) مقادیر V_A و V_{MN}

جواب:

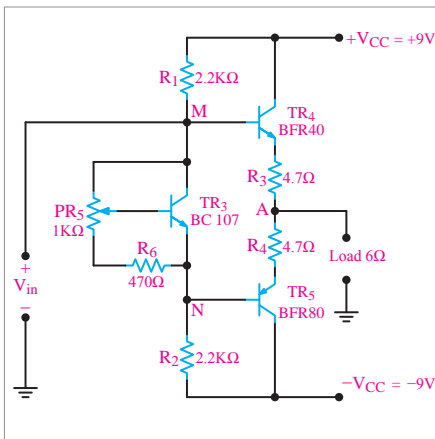
الف) تقویت کننده پوش پول کلاس AB

ب) ترانزیستورهای T_4 و T_5 را در آستانه

هدایت قرار می‌دهد.

ج) $V_{MN} = 2V_{BE}$

د) $V_A = 0$



۱

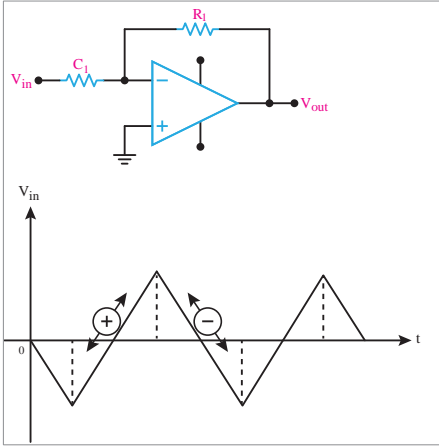
فصل ۲: تحلیل مدارهای الکترونیکی

| | | |
|--|---|---|
| | <p>با توجه به مدار مقابل، پاسخ دهید:</p> <p>(الف) نام مدار</p> <p>(ب) وظیفه D_1 , D_2</p> <p>(ج) ولتاژ V_A</p> <p>(د) آرایش ترانزیستور TR_1</p> <p>جواب:</p> <p>(الف) تقویت کننده پوش پوش پول کلاس AB</p> <p>(ب) ترانزیستورهای T_1 و T_2 را در آستانه هدایت قرار می دهد.</p> <p>(ج) $V_A = \frac{V_{CC}}{2}$</p> <p>(د) کلکتور مشترک</p> | ۲ |
| <p>روش های از بین بردن اعوجاج تقاطعی در تقویت کننده پوش پوش پول را بنویسید و کدام روش بهترین است؟</p> <p>جواب: ۱- پتانسیومتر ۲- دو عدد دیود ۳- رگولاتور موازی روش سوم بهترین روش است</p> | ۳ | |
| <p>در تقویت کننده پوش پوش پول استفاده از زوج دارلینگتون چه مزیتی دارد؟</p> <p>جواب: بهره جریان را بالا می برد.</p> | ۴ | |

کاربردهای تقویت کننده عملیاتی

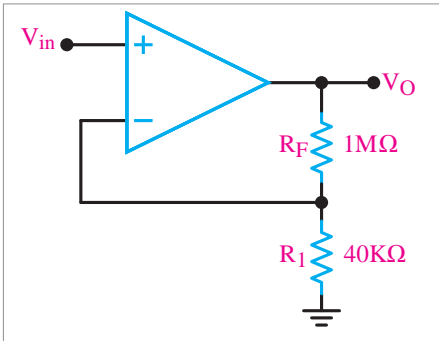
| | | |
|---|---|---|
| | <p>در مدار روبه رو ولتاژ خروجی چند ولت است؟</p> <p>جواب: $V_o = -6/37$</p> | ۱ |
| <p>یک مدار آشکارساز عبور از صفر می تواند موج سینوسی را به موج تبدیل کند.</p> <p>جواب: مربعی</p> | ۲ | |

نام مدار زیر چیست؟ و شکل موج خروجی آن را رسم کنید؟
 جواب: مشتق گیر



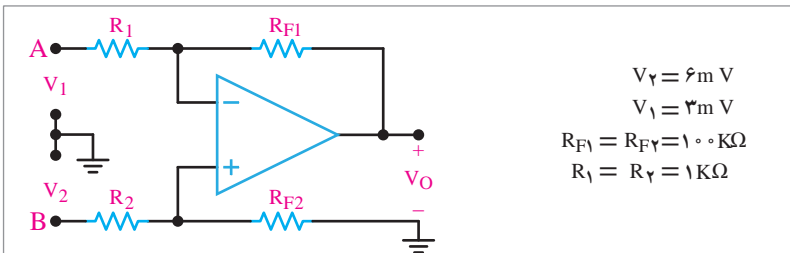
۳

با توجه به مدار مقابل، پاسخ دهید:
 الف) نام مدار
 ب) بهره تقویت کننده
 جواب:
 الف) تقویت کننده غیر معکوس گر
 ب) $A_v = 26$



۴

در مدار زیر ولتاژ خروجی چند ولت است؟
 جواب: $V_o = 300\text{ mV}$



$$V_2 = 6\text{ mV}$$

$$V_1 = 3\text{ mV}$$

$$R_{F1} = R_{F2} = 100\text{ K}\Omega$$

$$R_1 = R_2 = 1\text{ K}\Omega$$

۵

فصل ۲: تحلیل مدارهای الکترونیکی

| | | |
|--|---|---|
| | <p>در مدار روبه‌رو ولتاژ خروجی چند ولت است؟ جواب: $V_o = -18V$</p> | ۶ |
| <p>با توجه به مدار زیر، پاسخ دهید: الف) نام مدار ب) اگر شکل موج ورودی سینوسی باشد شکل خروجی را رسم کنید؟</p> | <p>جواب: الف) آشکارساز عبور از صفر ب) مربعی</p> | ۷ |
| <p>با توجه به مدار مقابل، پاسخ دهید: الف) محاسبه مقدار R_2 ب) مقدار R_2 چقدر انتخاب شود تا مدار به بافر منفی تبدیل شود</p> | <p>جواب: الف) $R_2 = 100k$ ب) $R_2 = 10k$</p> | ۸ |
| <p>در مدار روبه‌رو ولتاژ خروجی چند ولت است؟ جواب: $V_o = 1V$</p> | <p>در مدار روبه‌رو ولتاژ خروجی چند ولت است؟ جواب: $V_o = 1V$</p> | ۹ |

| نمره | شاخص تحقق | نتایج مورد انتظار | استاندارد عملکرد (کیفیت) | تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری) | عنوان بودمان |
|------|--|-----------------------|---|---|---------------------------------------|
| ۲ | تعیین انواع بایاس ترانزیستور، منحنی مشخصه‌ها، محاسبات انواع آرایش‌های ترانزیستور تعیین میزان تقویت‌مدمشترک و تفاضلی، تعیین مشخصات پوش پول، تعیین خروجی آپ آمپ در کاربردهای مختلف، تحلیل Jfet و mosfet برای کار در ناحیه فعال، تعیین آرایش moseft برای کاربرد در مدارات مجتمع | بالتر از حد انتظار | بررسی مفاهیم و محاسبات مربوط به | ۱- تحلیل فنی ترانزیستورها، انواع آرایش آنها و تحلیل تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری | بودمان ۲: تحلیل مدارهای الکترونیکی |
| ۲ | تعیین انواع بایاس ترانزیستور، منحنی مشخصه‌ها، محاسبات انواع آرایش‌های ترانزیستور، تعیین میزان تقویت مد مشترک و تفاضلی، تعیین مشخصات پوش پول، تعیین خروجی آپ آمپ در کاربردهای مختلف | در حد انتظار | کاربرد ترانزیستورها و آپ امپ‌ها به عنوان تقویت‌کننده در مدارات الکترونیکی | ۲- تحلیل تقویت‌کننده‌های عملیاتی و کاربرد آنها | |
| ۱ | تعیین انواع بایاس ترانزیستور، منحنی مشخصه‌ها، محاسبات انواع آرایش‌های ترانزیستور، تعیین میزان تقویت مد مشترک و تفاضلی | پایین تر از حد انتظار | | | |
| | | | | نمره مستمر از ۵ | |
| | | | | نمره شایستگی بودمان | |
| | | | | نمره بودمان از ۲۰ | |